

Requested Patent: JP2000276707A

Title: RECORDING/REPRODUCING SEPARATED MAGNETIC HEAD ;

Abstracted Patent: JP2000276707 ;

Publication Date: 2000-10-06 ;

Inventor(s):

MIMA HIROYUKI; MEGURO SATOSHI; FUKUI HIROSHI; TORII ZENZO; IKEUCHI SHITSUICHI ;

Applicant(s): HITACHI METALS LTD;; HITACHI LTD ;

Application Number: JP19990081964 19990325 ;

Priority Number(s): ;

IPC Classification: G11B5/31 ;

Equivalents: ;

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make the track width narrowable and to facilitatable the control of the gap depth by providing an upper magnetic pole with respectively separated magnetic pole part, magnetic pole and yoke part, forming the magnetic pole part on an insulating layer for gap depth regulation on a gap layer on the magnetic recording side and magnetically connecting the yoke part to the upper surface of the magnetic pole part and the upper surface of the magnetic pole at the same height.SOLUTION: A gap layer 3 is formed on a lower magnetic pole 2 and an insulating layer 4 for gap depth regulation is formed at a part of the gap layer 3. A magnetic pole part 5 is formed on the insulating layer 4 for gap depth regulation by a resist 31. The height of the resist 31 can be determined and reduced corresponding to the height of the magnetic pole part 5 regardless of a coil or yoke part 12 and the track width of the magnetic pole part 5 can be formed narrow. A notched part 9 is formed on the magnetic recording side of the magnetic pole part 5 corresponding to the thickness of the insulating layer 4 for gap depth regulation and filled with a non-magnetic substance. The gap depth of the magnetic pole part 5 can be determined by the top end portion of the insulating layer 4 for gap depth regulation and can be highly accurately controlled.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-276707

(P2000-276707A)

(43)公開日 平成12年10月6日 (2000.10.6)

(51)IntCl.⁷
G 11 B 5/31

識別記号

F I
G 11 B 5/31

デマコ (参考)
D 5 D 0 3 3
C
K

審査請求 未請求 請求項の数27 OL (全 15 頁)

(21)出願番号 特願平11-81964

(22)出願日 平成11年3月25日 (1999.3.25)

(71)出願人 000005083
日立金属株式会社
東京都港区芝浦一丁目2番1号
(71)出願人 000005108
株式会社日立製作所
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
(72)発明者 美馬 宏行
栃木県真岡市松山町18番地 日立金属株式
会社電子部品事業部内
(74)代理人 100082304
弁理士 竹本 松司 (外4名)

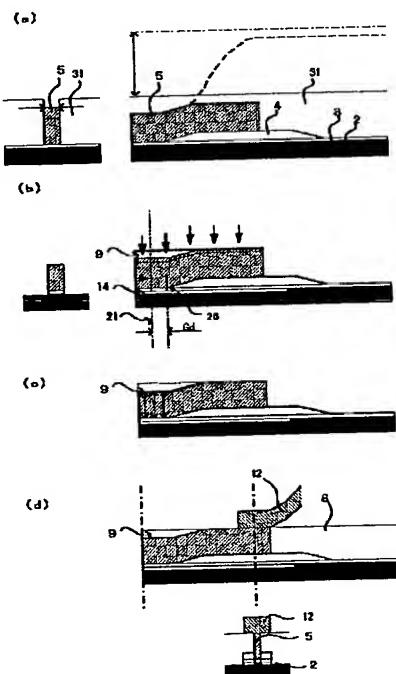
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 記録再生分離型磁気ヘッド

(57)【要約】

【課題】 狹トラック幅、ギャップ深さの制御、上部磁極の組成変動や膜厚の抑制等により記録再生分離型磁気ヘッドを小型化し、高容量化する。

【解決手段】 上部磁極を磁極部と磁極柱とヨーク部に分離した構成とすると共に、コイル層やヨーク部を形成する前段階の、磁極部を形成する面が平坦な状態で記録ヘッド部分の磁極部を形成することによって、下部磁極上に積層したコイルや絶縁層によってギャップ層との間に生じる段差により生じる障害を解決し、記録再生分離型磁気ヘッドを小型化し、高容量化する。上部磁極はそれぞれ分離した磁極部と磁極柱とヨーク部とを備え、磁極部は磁気記録面側においてギャップ層上及び該ギャップ層上に形成されたギャップ深さ規定用絶縁層上に形成し、ヨーク部は磁極部の上部面と磁極柱の上部面において同一高さで磁気的に接続する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも磁気記録面側においてギャップ層を挟んで対峙させて磁気回路を構成する下部磁極と上部磁極を備えた記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、上部磁極はそれぞれ分離した磁極部と磁極柱とヨーク部とを備え、前記磁極部は磁気記録面側においてギャップ層上及び該ギャップ層上に形成されたギャップ深さ規定用絶縁層上に形成され、前記ヨーク部は磁極部の上部面と磁極柱の上部面において同一高さで磁気的に接続することを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項2】 請求項1記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極部はヨーク部の形成前に独立して形成することを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項3】 請求項1記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極部の厚さは、磁極柱の厚さより少なくともギャップ深さ規定用絶縁層の厚さ分だけ薄いことを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項4】 請求項1、3記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極部の下方のギャップ層及び下部磁極のトラック幅への整形と、磁極部及び磁極柱の高さ調整とは、同一のミーリングによって同時に形成されるものであることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項5】 請求項1、3記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極部と磁極柱とは同一高さにおいてヨーク部と接触することを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項6】 請求項1、3、5記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極部とヨーク部の接触部分の深さ方向の長さは、磁極部の厚さよりも大きいことを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項7】 請求項1、3～6記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極部と接触するヨーク部の磁極柱側の端部は、磁極部の後端と同位置あるいは後方であることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項8】 請求項1、3～7記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極柱と接触する側のヨーク部の深さ方向の長さは磁極柱の深さ方向の長さより長いことを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項9】 請求項1、3～8記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極柱と接触する側のヨーク部の面積は磁極柱の面積より大きいことを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項10】 請求項1、3～9記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極柱と接触する側のヨーク部の後端は磁極柱の後端より前方にあることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項11】 請求項1記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、ギャップ深さ規定用絶縁層の磁気記録面側の端部をギャップ深さを規定する端部とすることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項12】 請求項1記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極部は、磁極部のギャップ層上に形成される上部面をギャップ深さ規定用絶縁層上に形成される磁極部の上部面より低くする切り欠き部を備え、該切り欠き部の上部面は、ギャップ深さ規定用絶縁層上に形成される磁極部の上部面と同一高さであることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項13】 請求項12記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、切り欠き部の厚さは、ギャップ深さ規定用絶縁層の厚さより低いことを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項14】 請求項12記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、切り欠き部の後端とギャップ深さ規定用絶縁層の前端は、磁気記録面からほぼ同一の深さにあることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項15】 請求項12記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極部と接触するヨーク部の磁気記録面側の端部は、切り欠き部の後端と同位置あるいは後方であることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項16】 請求項12記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、切り欠き部内及び磁極部と磁極柱との間の凹部は、非磁性材で埋設され、磁極部と非磁性材と磁極柱の各上部面は同一の平面を形成することを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項17】 請求項16記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極部と磁極柱との間の凹部に埋設された非磁性材の平面上にコイルを形成することを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項18】 請求項16記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、前記平面はケミカルメカニカルポリシング(CMP)により形成されることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項19】 請求項1～18記載のいずれかの記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、ギャップ層上に形成される磁極部の上部面の高さは、ギャップ深さの区間において同一高さであることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項20】 請求項1～18記載のいずれかの記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極部と磁極柱とヨーク部は同一組成であることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項21】 請求項1～18記載のいずれかの記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極部と磁極柱とヨーク部は異なる組成であることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項22】 請求項21記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、磁極部の飽和磁束密度はヨーク部の飽和磁束密度より大きいことを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項23】 請求項21記載の記録再生分離型磁気

ヘッドにおいて、磁極部の比抵抗はヨーク部の比抵抗より小さいことを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項24】 請求項20～23記載の記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、ヨーク部の厚さは磁極部の厚さより薄いことを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項25】 少なくとも磁気記録面側においてギャップ層を挟んで対峙させて磁気回路を構成する下部磁極と上部磁極を備えた記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、前記磁気記録面は、下部磁極、ギャップ層、上部磁極、非磁性層、及びオーバーコート部の積層面を露出して備えることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項26】 少なくとも磁気記録面側においてギャップ層を挟んで対峙させて磁気回路を構成する下部磁極と上部磁極を備えた記録再生分離型磁気ヘッドにおいて、上部磁極はそれぞれ分離した磁極部と磁極柱とヨーク部とを備え、前記上部磁極は、下部磁極、ギャップ層、ギャップ深さ規定用絶縁層、上部磁極及び磁極柱を順に積層して形成した後、上部磁極と該上部磁極が形成されるギャップ層及び下部磁極のミリングにより形成し、前記磁極柱は、上部磁極の形成後に非磁性材を積層し、上部磁極の一部と共に露出させて同一高さの平面とし、前記ヨーク部は平面及びコイルの上方に形成されることを特徴とする記録再生分離型磁気ヘッド。

【請求項27】 請求項1～26記載のいずれかにおいて、記録再生分離型磁気ヘッドをスライダーとし、磁気記録面を浮上面とする磁気記録装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、記録再生分離型の磁気ヘッドに関し、特に基板上に下部磁極層、磁気ギャップ層および上部磁極層を形成してなる磁気抵抗効果型磁気ヘッドの記録ヘッドに関する。

【0002】

【従来の技術】記録再生分離型磁気ヘッドは、記録ヘッド部と再生ヘッド部とを分離して備える磁気ヘッドであり、MRヘッドやGMRヘッドやTMRヘッド等が知られている。

【0003】記録ヘッド部の一構成として、膜状の下部磁極と上部磁極の間にギャップ層を設け、上部磁極と下部磁極とを磁気的に接続し、上部磁極と下部磁極の接続部周囲にコイル層を設け、上部磁極を保護層で覆う薄膜磁気ヘッドが知られている。

【0004】図8、9は記録再生分離型磁気ヘッドの一構成例の概略図及び断面図である。図8、9において、記録再生分離型磁気ヘッドは記録ヘッド部100と再生ヘッド部120とを備える。記録ヘッド部100は、下部磁極102と上部磁極105とをギャップ層103を挟んで対面して配置させて構成している。また、再生ヘッド部120は、上部シールド102（下部磁極102と兼用する）と下部シールドとの間に再生素子121を

配置して構成している。また、記録ヘッド及び再生ヘッドと外部との間は引き出し端子113及び端子114を介して接続している。

【0005】なお、以下の説明では、記録ヘッド部分のみ示し、再生ヘッド部分については省略する。また、記録再生分離型磁気ヘッドは単に磁気ヘッドとして説明する。

【0006】磁気媒体に対する記録は、磁気ヘッドのギャップ層の先端面を磁気媒体に対向させ、下部磁極、磁気媒体、上部磁極によって磁気回路を形成し、この磁気回路に生じる磁気変化を利用して行っている。

【0007】従来より、磁気ヘッドの記録ヘッド部の磁極の形成には、下部磁極と上部磁極をマスクを利用してスパッタで形成する方法、下部磁極と上部磁極を成膜した後、イオンミリングで所定寸法に加工する方法、下部磁極と上部磁極をめっきで成膜した後、ケミカルエッチングで所定寸法にエッチングする方法等の種々の方法が用いられている。

【0008】また、トラック幅分だけ間隔を開けて一对のレジスト部を設け、このレジスト部間に下部磁極とギャップ層と上部磁極を、金属材料によるめっきで形成する薄膜磁気ヘッド（特開平6-28626号公報）も知られている。

【0009】図10は従来の磁気ヘッドの記録ヘッド部の一形成工程例を示す図である。なお、図10では、左方に磁気記録面（浮上面（ABS））側から見た図を示し、右方に磁気記録面（浮上面（ABS））側から奥行き方向への断面図を示している。なお、磁気ヘッドをスライダーに適用した場合には、磁気記録面は浮上面（ABS）となる。

【0010】図10に示す磁気ヘッドの記録ヘッド部は、基板上に下部磁極101、102を形成し、下部磁極102上に非磁性体をスパッタしてギャップ層103を形成し、ギャップ層103の一部をエッチングしてバックスルーホール115を形成した後、ギャップ層103上に絶縁層104を形成する（図10（a））。

【0011】絶縁層104上にコイル110を形成した後（図10（b））、絶縁層111を形成し、さらにコイル110'及び絶縁層111を形成して多層コイルを形成する（図10（c））。さらに、露出しているギャップ層103、絶縁層111、及びバックスルーホール115上に上部磁極105をめっきで形成する（図10（d））。

【0012】上部磁極105を形成した後、イオンミリングによって絶縁層103及び下部磁極102、101をトリムして、上部磁極105と下部磁極102、101の幅をトラック幅にそろえる（図10（e））。

【0013】

【発明が解決しようとする課題】磁気ヘッドの小型化や磁気ヘッドを用いた磁気記録装置の高容量化に伴って、

より狭いトラック幅で高精度の磁気ヘッドが求められている。現在の磁気ヘッドでは、トラック幅は $0.9\mu m$ が限界であるが、 $10Gb$ の大容量の磁気ヘッドでは $0.6\mu m$ のトラック幅が必要となる。

【0014】しかしながら、従来の磁気ヘッドの記録ヘッド部の構成では、狭トラック幅化や高精度化に限界が生じている。発明者は、この磁気ヘッドの狭トラック幅化や高精度化の障害となっている一要因に素子の段差があることを見い出した。

【0015】従来の磁気ヘッドの記録ヘッド部では、下部磁極上に積層したコイルや絶縁層によってギャップ層との間に段差が生じる。この段差は、狭トラック幅化を困難とし、ギャップ深さの制御を困難とし、また、上部磁極の場所による組成変動や膜厚の不均一を起こし、磁気特性の制御を困難としている。

【0016】図11は従来の磁気ヘッドの記録ヘッド部の問題点を説明するための図である。図11(a)は段差がトラック幅の形成におよぼす影響を説明する図である。上部磁極105を形成するには、下部磁極100及び絶縁層103上にコイル110及び絶縁層111を形成した後、レジスト131を形成し、このレジスト131にトラック幅Twの幅の溝133を形成する。この溝133内にメッキを行うことによって、上部磁極105の磁気記録面側のトラック幅を所定の幅に形成する。

【0017】上部磁極105は、トラック幅を形成する側及びコイル110側に形成する必要があるため、形成されるレジスト131の膜厚Aはコイル110及び絶縁層111で形成される段差に応じて高くなり、 $10\mu m$ 以上が必要である。しかしながら、狭いスリットを深く形成することには限界があり、 $10\mu m$ 以上の膜厚にたとえば $0.6\mu m$ 程の狭いスリットを形成して、絶縁層103まで到達する溝133を形成することは困難であるという問題がある。溝133の底が絶縁層103の面まで届かない場合には、磁気ヘッドの磁極ギャップの幅を所定値とすることはできない。

【0018】図12は上部磁極を形成するためのレジストを説明するための概略斜視図である。レジスト131はコイルや絶縁層111よりも高い膜厚で形成される(図12(a))。溝133は、狭いトラック幅Twで、レジスト131の上面から形成されるが、形成できる深さには限界があるため、膜厚Aが厚い場合にはギャップ層を構成する絶縁層103まで到達することができない。

【0019】図11(b), (c)は段差がギャップ深さの制御におよぼす影響を説明する図である。

【0020】磁気ヘッドの磁気記録特性を定める一パラメータとしてギャップ深さGd(あるいはスロートハイトとも云う)がある。このギャップ深さGdは磁気記録面から上部磁極の後端までの距離であり、絶縁層の磁気記録面側の先端の位置によって定めることができる。図

11(b)は、後工程で形成する絶縁層111によってギャップ深さGdを定める場合を示している。

【0021】膜厚Aが厚い場合には後工程で形成する絶縁層111は、積層したコイル等の厚さによって絶縁層103との段差によって膜厚Aが大きいため、その絶縁層の磁気記録面側の先端位置Bを精度良く制御することが困難である。絶縁層の先端位置Bのずれはギャップ深さGdのずれとなるため、段差が大きい場合にはギャップ深さGdを高精度に制御することができないという問題がある。

【0022】図11(b)に対して、図11(c)は先の工程で形成する絶縁層104によってギャップ深さGdを定める場合を示している。この絶縁層104によれば、段差に係わらずに先端位置Cを定めることができ。しかしながら、絶縁層104を形成した後の工程によって、絶縁層104の先端位置Cは図中の矢印のように位置Dに後退する。したがって、先の工程で形成する絶縁層104を用いた場合にも、ギャップ深さGdを高精度に制御することができないという問題がある。

【0023】また、図11(d)は段差が上部磁極の組成や膜厚におよぼす影響を説明する図である。上部磁極等の磁気回路の磁路構成部分をめっきで形成する場合、めっき形成面に段差があると膜厚や組成が場所によって異なり、磁路構成部分の膜厚や組成を均一とすることができないという問題がある。この磁路構成部分における膜厚や組成の不均一性は、磁気ヘッドの磁気特性に影響を与え、所望とする記録再生特性を得ることができない場合がある。組成や膜厚の不均一性は、特にNiFeめっきにおいてFe成分が多い組成(45NiFe ($\text{Ni}45\text{wt\%}\text{Fe}5\text{wt\%}$))の場合に顕著となる。

【0024】上部磁極105をめっき形成すると、浮上面側及びバックスルーホール側とこの両者の中間部分との間に段差が生じる。上部磁極の浮上面側Fとバックスルーホール側Gとの中間部分Eを基準とすると、 83NiFe ($\text{Ni}83\text{wt\%}\text{Fe}17\text{wt\%}$)では磁気記録面側Fとバックスルーホール側Gにおいて膜厚が2%増加し、Ni組成がほぼ1(wt%)増加する。また、 45NiFe では浮上面側Fとバックスルーホール側Gにおいて膜厚が10%減少し、Ni組成がほぼ2(wt%)増加する。

【0025】磁気記録面側Fは磁気記録媒体に近接する個所であり、浮上面側Fの上部磁極の膜厚が薄い場合には、薄膜磁気ヘッドのO/W(オーバーライト)特性が悪化することになる。また、ギャップ深さGdを設定するために、磁気記録面を切削して絶縁層104の先端位置APEXとの距離を定める際、磁気記録面側Fの高さ(厚さ)Hが位置によって変動している場合には、切削位置によってその高さ(厚さ)Hが変動することになる。

【0026】この組成および膜厚の変動は、金属析出と

同時に水素が発生し、特に微細パターン部分では共析水素および水素イオンの蓄積によって、析出界面のPHがめっき面の近傍で変動し、その結果PHに依存した組成変動が起こりやすくなるためと考えられ、また、特にFeを含む合金めっきでは、標準酸化還元電位（イオン化傾向）が卑な金属（イオン化し易い金属）が優先的に析出する“変則共析”という現象が起きるため、微細パターン部分での水素および水素イオンの界面蓄積により界面PHが変動し、組成変動や膜厚変動が起こりやすくなるためと考えられる。

【0027】上記のように、従来の磁気ヘッドの記録ヘッド部では、下部磁極上に積層したコイルや絶縁層によってギャップ層との間に生じる段差によって、トラック幅の狭幅化、ギャップ深さの制御、上部磁極の組成変動や膜厚の不均一等による磁気特性制御等の点で問題があり、磁気ヘッドを小型化、高容量化する上で障害となっている。

【0028】そこで、本発明は前記した従来の問題点を解決して、磁気ヘッドを小型化、高容量化することを目的とする。さらに詳細には、下部磁極上に積層したコイルや絶縁層によってギャップ層との間に生じる段差による問題点を解決し、狭いトラック幅を備える記録再生分離型磁気ヘッドを提供することを目的とし、ギャップ深さの容易な制御が容易な記録再生分離型磁気ヘッドを提供することを目的とし、上部磁極の組成変動や膜厚の不均一を抑制し、磁気特性の制御を容易とすることができる記録再生分離型磁気ヘッドを提供することを目的とする。

【0029】

【課題を解決するための手段】本発明は、上部磁極を磁極部と磁極柱とヨーク部に分離した構成と共に、コイル層やヨーク部を形成する前段階の、磁極部を形成する面が平坦な状態において磁極部を形成することによって、下部磁極上に積層したコイルや絶縁層によってギャップ層との間に生じる段差により生じる障害を解決するものである。

【0030】本発明によれば、磁極部の形成に用いるレジストの高さ（厚さ）を低くすることができるため、狭いトラック幅を形成することができる。また、磁極部は後工程の影響を受けないため、ギャップ深さや磁極部の高さ（厚さ）の制御を容易とすることができます。また、磁極部と磁極柱とヨーク部の組成を個別に制御することができるため、上部磁極の組成変動や膜厚の不均一を抑制することができる。

【0031】図1は本発明の記録再生分離型磁気ヘッドを説明するための概略図である。なお、図1は記録再生分離型磁気ヘッドの記録ヘッド部分の一部を示しており主に磁極部の断面部分を示している。図1(a)は本発明による狭トラック幅の形成を説明するための図であり、図1(b)は本発明によるギャップ深さの制御の容

易さを説明するための図であり、図1(c)は本発明による磁極部の高さ（厚さ）の制御の容易さを説明するための図であり、図1(d)は本発明による上部磁極の組成変動や膜厚の抑制等を説明するための図である。

【0032】なお、以下の各図の説明において、磁気ヘッドにおいて磁気記録面を前方方向として磁気記録面から磁気ヘッドの後端方向への位置及び距離を深さで表し、下部磁極側を下方向として下部磁極から上方向に向かう位置及び距離をそれぞれ高さ及び厚さで表すこととする。また、以下の説明では、記録ヘッド部分のみ示し、記録再生分離型磁気ヘッドは磁気ヘッドで表している。

【0033】はじめに、狭トラック幅の形成について説明する。図1(a)において、下部磁極2上にはギャップ層3が形成され、ギャップ層3の一部にはギャップ深さ規定用絶縁層4が形成される。磁極部5はギャップ層3上及びギャップ深さ規定用絶縁層4上に、レジスト31によって形成される。レジスト31の高さ（厚さ）は、コイルやヨーク部（図示していない）と無関係に磁極部5の高さ（厚さ）で定めることができるため、従来よりも低く（薄く）形成することができる。レジスト31の高さ（厚さ）を低く（薄く）することによって、磁極部5のトラック幅Twを狭く形成することができる。レジスト膜厚を一例として4μm程度とすることによって、トラック幅Twを0.5μm程度まで狭めることができる。

【0034】次に、ギャップ深さの制御の容易さについて説明する。図1(b)において、磁極部5をレジスト31を用いてめっき等で形成した後、イオンミリング等によって磁極部5の部分のギャップ層3及び下部磁極2をトリムし、ギャップ層3及び下部磁極2の幅を磁極部5のトラック幅Twの整形する。磁極部5の磁気記録面側には、ギャップ深さ規定用絶縁層4の厚さによって切り欠き部9が形成され、この切り欠き部9は非磁性体で埋設される。

【0035】したがって、磁極部5のギャップ深さGdは、ギャップ深さ規定用絶縁層4の先端部分(APEX)で定まり、この位置は磁気記録面側の切削工程やヨーク部の形成工程等の後工程に影響されないため、高精度に制御することができる。

【0036】次に、磁極部の高さ（厚さ）の制御の容易さについて説明する。図1(c)において、前記図1(b)で示したように、磁極部5のギャップ深さの区間において、磁極部5はギャップ層3の平らな面上に形成され、また、ミリングでトリムされた後には、磁極部5の上面部分は切り欠き部9の非磁性体で覆われるため。そのため、ギャップ深さの区間では磁極部5の厚さは一定となる。したがって、磁気記録面側の切削工程で深さ方向に切削しても、磁極部5の厚さは、ミリング時に定めた一定の厚さとなる。

【0037】次に、上部磁極の組成変動や膜厚の抑制等

について説明する。図1(d)において、磁極部5を形成した後、該磁極部5に磁気的に接続するようにヨーク部12を形成する。磁極部5とヨーク部12とを分離し、別工程で形成することにより、各部分の組成及び膜厚を任意に制御することができる。

【0038】また、磁気記録面において、磁極部5及び切り欠き部9の側部は非磁性材で埋設し、磁極部5及び切り欠き部9の上面と同一高さにする。これによって、磁極部5上に形成するヨーク部12の幅を大きくとることができ、磁極部5とヨーク部12との位置合わせを容易とすることができる効果、及び磁極部5とヨーク部12の接合個所付近におけるすの発生を防止することができる効果がある。

【0039】上記したように、狭いトラック幅の形成、ギャップ深さの容易な制御、上部磁極の組成変動や膜厚の不均一の抑制等によって、磁気ヘッドを小型化し、また高容量化することができる。

【0040】上記した本発明の磁気ヘッドは、以下の各形態によって構成することができる。本発明の第1の形態は、少なくとも磁気記録面側においてギャップ層を挟んで対峙させて磁気回路を構成する下部磁極と上部磁極を備えた磁気ヘッドにおいて、上部磁極はそれぞれ分離した磁極部と磁極柱とヨーク部とを備え、磁極部は磁気記録面側においてギャップ層上及び該ギャップ層上に形成されたギャップ深さ規定用絶縁層上に形成し、ヨーク部は磁極部の上部面と磁極柱の上部面において同一高さで磁気的に接続する構成である。

【0041】この構成によって、上部磁極を磁極部と磁極柱とヨーク部に分離した構成とし、また、磁極部をコイル層やヨーク部を形成する前段階の、磁極部を形成する面が平坦な状態において磁極部を形成する。

【0042】第1の形態において、磁極部はヨーク部の形成前に独立して形成し、また、磁極部の厚さは、磁極柱の厚さより少なくともギャップ深さ規定用絶縁層の厚さ分だけ薄い構成とする。これによって、ギャップ深さの制御及び磁極部の高さ(厚さ)を高精度に制御することができる。

【0043】また、第1の形態において、同一のミリングによって、磁極部の下方のギャップ層及び下部磁極のトラック幅への整形と、磁極部及び磁極柱の高さ調整とを同時にを行うことができ、工程を簡略化することができる。

【0044】第1の形態において、磁極部とヨーク部との関係において以下の構成とることができる。上記関係の第1の構成は、磁極部と磁極柱とは同一高さにおいてヨーク部と接触する構成である。上記関係の第2の構成は、磁極部とヨーク部の接触部分の深さ方向の長さを、磁極部の厚さよりも大とする構成であり、この構成によって磁気特性を向上させることができる。上記関係の第3の構成は、磁極部と接触するヨーク部の磁極柱側

の端部を、磁極部の後端と同位置あるいは後方とする構成であり、この構成によってヨーク部形成時における位置ずれを吸収することができる。上記関係の第4の構成は、磁極柱と接触する側のヨーク部の深さ方向の長さを磁極柱の深さ方向の長さより長くする構成であり、この構成によってヨーク部形成時における位置ずれを吸収することができる。上記関係の第5の構成は、磁極柱と接触する側のヨーク部の面積は磁極柱の面積より大とする構成であり、この構成によってヨーク部形成時における位置ずれを吸収することができる。上記関係の第6の構成は、磁極柱と接触する側のヨーク部の後端を磁極柱の後端より前方とする構成であり、この構成によってヨーク部形成工程を容易なものとすることができます。

【0045】また、第1の形態について、ギャップ深さ規定用絶縁層の磁気記録面側の端部をギャップ深さを規定する端部とすることができ、この構成によってギャップ深さの制御を容易とすることができます。

【0046】さらに、第1の形態において、磁極部は以下の構成とすることができます。磁極部は、磁極部のギャップ層上に形成される上部面をギャップ深さ規定用絶縁層上に形成される磁極部の上部面より低くする切り欠き部を備え、切り欠き部の上部面は、ギャップ深さ規定用絶縁層上に形成される磁極部の上部面と同一高さである構成である。切り欠き部は、磁極部の高さを定める基準となる。

【0047】上記磁極部の構成が備える切り欠き部において、以下の構成とができる。切り欠き部における第1の構成は、切り欠き部の厚さをギャップ深さ規定用絶縁層の厚さより低い構成である。切り欠き部における第2の構成は、切り欠き部の後端とギャップ深さ規定用絶縁層の前端を、磁気記録面からほぼ同一の深さとする構成とする。これは、ギャップ深さ規定用絶縁層の前端によってギャップ深さが定まり、少なくともこのギャップ深さの区間において磁極部の高さを一定とするためである。

【0048】切り欠き部における第3の構成は、磁極部と接触するヨーク部の磁気記録面側の端部を、切り欠き部の後端と同位置あるいは後方とする構成とする。これは、ヨーク部は少なくとも磁極部と磁気的に接続するためである。切り欠き部における第4の構成は、切り欠き部内及び磁極部と磁極柱の間の凹部を非磁性材で埋設し、磁極部と非磁性材と磁極柱の各上部面を同一の平面とする構成とする。この非磁性材は熱伝導性が良い絶縁材とし、これによって、コイルから発生する熱の放熱を良好に行うことができる。

【0049】また、上記切り欠き部における第5の構成において、磁極部と磁極柱の間の凹部に埋設された非磁性材の平面上にコイルを形成し、また、該平面をケミカルメカニカルポリシング(CMP)により形成する。平面とすることによりコイルの形成を容易とすることができます。

きる。また、ケミカルメカニカルポリシングによる機械的な切削によって平坦性及び寸法の制御を容易とすることができる。

【0050】第1の形態において、ギャップ層上に形成される磁極部の上部面の高さを、ギャップ深さの区間ににおいて同一高さとし、これによって磁極部の高さ（厚さ）を高精度に制御することができる。

【0051】また、第1の形態において、磁極部と磁極柱とヨーク部の組成を同一組成あるいは異なる組成に任意に形成することができる。同一組成とする場合には、磁極部とヨーク部の組成のばらつきを一例として従来の3wt%から0.5wt%に改善することができる。

【0052】異なる組成とする場合において、磁極部の飽和磁束密度をヨーク部の飽和磁束密度より大とする構成によって、大きな記録磁界を得ることができ、大きなO/W（オーバーライト）を得ることができる。また、磁極部の比抵抗をヨーク部の比抵抗より小とする構成によって、渦電流損を低減し、高い周波数に対応することができる。

【0053】また、第1の形態において、ヨーク部の厚さを磁極部の厚さより薄く形成し、インダクタンスを低減してNLT S（非線形性）を改善させることができます。

【0054】本発明の第2の形態は、少なくとも磁気記録面側においてギャップ層を挟んで対峙させて磁気回路を構成する下部磁極と上部磁極を備えた磁気ヘッドにおいて、磁気記録面は下部磁極、ギャップ層、上部磁極、非磁性層、及びオーバーコート部の積層面を露出して備える構成である。

【0055】第2の形態によれば、上部磁極の上方に位置する非磁性層の存在によって、上部磁極の厚さはギャップ深さによって影響されず、形成時のばらつきを抑制することができる。

【0056】また、本発明の第3の形態は、少なくとも磁気記録面側においてギャップ層を挟んで対峙させて磁気回路を構成する下部磁極と上部磁極を備えた磁気ヘッドにおいて、上部磁極はそれぞれ分離した磁極部と磁極柱とヨーク部とを備え、上部磁極は、下部磁極、ギャップ層、ギャップ深さ規定用絶縁層、上部磁極及び磁極柱を順に積層して形成した後、上部磁極と該上部磁極が形成されるギャップ層及び下部磁極のミリングにより形成し、磁極柱は、上部磁極の形成の後に非磁性材を積層し、上部磁極の一部と共に露出させて同一高さの平面とし、ヨーク部は平面及びコイルの上方に形成する構成である。

【0057】第3の形態によれば、上部磁極を磁極部と磁極柱とヨーク部に分離した構成に形成し、また、磁極部をコイル層やヨーク部を形成する前段階の、磁極部を形成する面が平坦な状態において磁極部を形成する。

【0058】また、上記した本発明の第1～3の形態に

おいて、磁気記録面を浮上面として、磁気ヘッドをスライダーとする磁気記録装置を構成することができる。本発明による磁気ヘッドをスライダーとする磁気記録装置によれば、磁気ヘッドの磁極のトラック幅Twを狭めることができるために、高密度記録及び高容量記録を行うことができる。また、磁気ヘッドの磁極部及びヨーク部の組成や厚さの制御が容易となるため、オーバーライト比や線形性や高周波特性が良好な磁気記録装置を得ることができる。

【0059】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図を参照しながら詳細に説明する。なお、以下の各図の説明において、磁気ヘッド（記録再生分離型磁気ヘッド）において磁気記録面を前方向として磁気記録面から磁気ヘッドの後端方向への位置及び距離を深さで表し、下部磁極側を下方向として下部磁極から上方向に向かう位置及び距離をそれぞれ高さ及び厚さで表すこととする。また、各図において、再生ヘッド部分を省略し、記録ヘッド部分のみ示している。

【0060】図2は本発明の磁気ヘッドの概略図であり、図2(a)は上部磁極側から見た平面図であり、図2(b)は磁極部を通る断面図である。図2(b)の断面図において、磁気ヘッド1は下部磁極2上に、ギャップ層3、ギャップ深さ規定用絶縁層4、磁極部5、磁極柱6、コイル層10、絶縁層11、ヨーク部12、及びオーバーコート部13等を積層して備え、磁極部5とヨーク部12と磁極柱6により上部磁極を構成し、この上部磁極とギャップ層3と下部磁極2とによって磁気回路を構成する。

【0061】磁気記録面21において、磁極部5とギャップ層3と下部磁極2の積層部分が露出し、磁極部5と下部磁極との間の磁束によって磁気情報の書き込みあるいは読み出しを行う。なお、磁気ヘッド1をスライダーとする場合には、磁気記録面21は浮上面ABS（エアーベアリングサーフェス）を構成する。

【0062】ギャップ層3は、下部磁極2上において、磁極柱6を形成するためのバックスルーホール15を除いて形成する。ギャップ深さ規定用絶縁層4は、磁極部5のギャップ深さGd（あるいはスロートハイドとも云う）を定めるものであり、磁気記録面21側の先端部分APEXがギャップ深さGdの後端位置となる。したがって、ギャップ深さ規定用絶縁層4は、磁気記録面21からギャップ深さGdの位置から後方に向かってレジストにより形成され、厚さは例えば1μm程度とすることができます。

【0063】磁極部5は、磁気記録面21側のギャップ層3からギャップ深さ規定用絶縁層4の一部にかけて形成する。磁極部5は段差を有した構造であり、ギャップ層3上に形成される磁極部5の高さはギャップ深さ規定用絶縁層4上に形成し磁極部5の高さより低く形成す

る。ギャップ層3上にある磁極部5の上部には、アルミナ等の非磁性材によって切り欠き部9を形成する。

【0064】磁極柱6は、下部磁極2上のギャップ層3が設けられていないバックスルーホール15部分に形成する。磁極部5と磁極柱6との間の空間部分は、埋め込まれて埋設部8を構成している。埋設部8の素材は、熱伝導性が良い絶縁体を用いることができ、アルミナ等の非磁性材を使用することができる。

【0065】切り欠き部9と磁極部5の一部と磁極柱6と埋設部8の上部面は、同一の高さであり同一面20を形成している。埋設部8の平面20上にはコイル層10及び絶縁層11が形成される。このコイル層と絶縁層は多層とすることができ、コイル層10及び絶縁層11の上方にコイル層10'及び絶縁層11'を積層することができる。

【0066】コイル層10及び絶縁層11の上方には、両端において磁極部5及び磁極柱6と接続するヨーク部12を形成する。ヨーク部12は平面20上において磁極部5と接続する。該磁極部5との接続部分において、ヨーク部12の磁気記録面側の端部24は、切り欠き部9の立ち上がり端部23と同位置、あるいは端部23から後方の位置とする。また、該接続位置において、ヨーク部12の磁気記録面21側の後端26は、磁極部5の後端25と同位置、あるいは後端25から後方の位置とする。

【0067】また、ヨーク部12は平面20上において磁極柱6と接続する。該磁極柱6との接続部分において、ヨーク部12の磁気記録面側の端部27は、磁極柱6の磁気記録面側の端部より前方とし、後方の端部28は、磁極柱6の後方の端部より前方とする。

【0068】切り欠き部9、磁極部5の一部、ヨーク部12、磁極柱6の一部の上方はアルミナ等の非磁性材によって覆い、オーバーコート部13を形成する。図2(a)はオーバーコート部13を上方から見た図であり、オーバーコート部13は磁極部5や磁極柱6と比較して十分広い面積を備える。

【0069】なお、図2において、Ly1はAPEXと切り欠き部9の立ち上がり上端との距離を示し、Ly2は切り欠き部9の立ち上がり上端とヨーク部12の広がり変化点(角度δ2)までの距離(距離の一例として6μm)を示し、Ly3は切り欠き部9の立ち上がり上端とヨーク部12の先端24との距離を示している。また、ヨーク部12の先端24と磁極部5の後端25との距離は、一例として3μmとする。また、ヨーク部12の先端24から前記変化点(角度2)までの広がり角度は角度δ1である。

【0070】また、APEXから磁極柱6の先端までの距離はLmで示し、ヨーク部12の磁気記録面21側の後端26からコイル層10の先端までの距離はLmfで示し、コイル層10の後端から磁極柱6の先端までの距

離はLmbで示し、コイル層10の先端と後端と間の距離はLmcで示している。また、磁極柱6の深さ方向の長さはLbg(一例として10μm)を示し、磁極柱6の先端から下部磁極2の後端までの距離はLupbで示し、磁極柱6の後端から下部磁極2の後端までの距離の一例は3μmである。

【0071】また、図2(a)において、磁極部5のトラック幅はTwで示し、磁極柱6の幅はWbgで示し、ヨーク部12の幅はW1で示し、下部磁極2の幅はWmidで示している。

【0072】次に、本発明の磁気ヘッドを形成する手順について、図3のフローチャート、図4, 5の手順を示した断面図、図6, 7の手順を示した斜視図を用いて説明する。なお、フローチャート中の(a)～(i)は、図4, 5の図番符号(a)～(i)と対応させて示している。なお、図4, 5の断面図において、断面図の左方に示す図は磁気記録面の図である。

【0073】はじめに、再生ヘッド部120を形成する。図8, 9に示すように、再生ヘッド部120は下部シールド122上に再生素子121を形成し、該再生素子121上に上部シールドを形成して構成する。記録ヘッド部100を再生ヘッド部120上に形成する。このとき、再生ヘッド部120の上部シールドは記録ヘッド部100の下部磁極102を兼ねている。

【0074】図4(a)において、下部磁極2を形成し(ステップS1)、該下部磁極2上のバックスルーホール15を除いた部分に絶縁層を設けてギャップ層3を形成する。ギャップ層3の厚さの一例として0.2μm程度とする(ステップS2)。さらに、ギャップ層3の上に、レジストによってギャップ深さ規定用絶縁層4を形成する。ギャップ深さ規定用絶縁層4の厚さの一例として1μm程度とする(ステップS3)。

【0075】次に、図4(b)において、磁極部5を形成するためのレジスト31を形成する。レジスト31は、磁極部5の厚さを形成するに足りる厚さであればよく、コイル層や絶縁層の厚さに対応した従来のレジストより薄く形成することができる。図6(a)はレジスト31を形成した状態を示している。

【0076】図4(c)において、レジスト31を形成した後、磁極部5を形成する部分、埋設部8となる部分、及び磁極柱6となる部分のレジストを除去して、溝33を形成する。図6(b)はレジスト31に溝33を形成した状態を示している。

【0077】磁極部5を形成する部分は、レジスト31にトラック幅Twの溝33を上面からギャップ層3まで形成する。レジスト31の厚さを5μmとした場合には、アスペクト比10とすれば0.5μmのトラック幅を形成することができる。

【0078】図4(d)において、レジスト31に形成した溝33を用いて、パーマロイ等をめっきして磁極部

らで形成する。パーマロイの組成は、磁極部5に対応して設定することができる。また、磁極柱6についても、磁極部5の形成と共にパーマロイ等のめっきで形成する。図6(c)は、溝33内に磁極部5を形成した状態を示している。

【0079】磁極部5及び磁極柱6を形成した後、レジスト31を除去する。磁極部5は、磁気記録面からギャップ深さまでのギャップ層3の部分と、ギャップ深さ規定用絶縁層4の一部にかけて形成する。このため、形成された磁極部5の高さは、ギャップ深さ規定用絶縁層4上に形成された部分は、ギャップ層3上に形成された部分よりも、ギャップ深さ規定用絶縁層4の厚さだけ高くなる。

【0080】また、図7(d)に示すように、磁極部5と磁極柱6との高さの関係は以下のようになる。磁極部5はギャップ層3上及びギャップ深さ規定用絶縁層4上に形成されているのに対して、磁極柱6は下部磁極2上に形成されている。そのため、ギャップ層3上に形成された磁極部5は、磁極柱6よりもギャップ層3の厚さだけ高くなる。また、ギャップ深さ規定用絶縁層4上に形成された磁極部5は、ギャップ層3の厚さとギャップ深さ規定用絶縁層4の厚さとを加算した厚さだけ高くなる(ステップS4)。

【0081】次に、磁極部5のミリングを行う。この磁極部5のミリングは、磁極部5の厚みを調整すると共に、磁極部5の下方にある絶縁層3及び下部磁極2の幅をトラック幅Twに合わせ整形の作用と、ステップS4の工程で形成された磁極部5と磁極柱6との高さの段差を無くして同等の高さとする作用との2つの作用を含む。

【0082】図7(e)に示すように、ミリングは、磁気記録面に露出する上部磁極部5を切削すると共に、絶縁層3及び下部磁極2を切削してミリング部14を形成する。この切削によって、絶縁層3と下部磁極2の幅を同一のトラック幅Twに整形される。絶縁層3を挟んで下部磁極2と磁極部5の幅をトラック幅Twの合わせることによって、磁気記録に寄与しない方向への磁束の広がりを抑制する。

【0083】また、磁極部5と磁極柱6との高さの段差を無くして同等の高さとする作用は、後工程でコイル層やヨーク部を形成する場合に、これらの形成面を平面とする。

【0084】この工程は、図4(e)において、磁極部5を除いてレジスト32を形成し磁極柱6を覆い、磁極部5をミリングする(ステップS5)。

【0085】磁極部5と磁極柱6との高さの段差をほぼ無くした後、図4(f)に示すように、レジスト32を除去し、磁極部5及び磁極柱6の上面、切り欠き部9内、及び磁極部5と磁極柱6とで挟まれる凹部(埋設部8)内に、熱伝導性が良い絶縁材7を積層し覆う。該絶縁材の一例としては、アルミナ等の非磁性材を用いるこ

とができる、アルミナスパッタリングにより行うことができる(ステップS6)。

【0086】次に、積層した絶縁材7をCMP(ケミカルメカニカルポリシング)によって研削する。図5(g)において、ギャップ深さ規定用絶縁層4上に形成されている磁極部5の一部分と、磁極柱6とが露出するまで絶縁材7を研削する。このCMPラップによる研削によって、切り欠き部9と磁極部5の一部と埋設部8と磁極柱6の各上面を同一の高さに平坦化する。この研削によって、前記ミリング工程ではほぼ同一高さにそろえられた磁極部5の一部と磁極柱6とは同一高さとなる。また、切り欠き部9及び埋設部8の埋め込まれた絶縁材の面も同一高さとなる。この同一高さの面は、図7(f)において面20で示している。

【0087】このとき、磁気記録面側の磁極部5の上面は、その上側は切り欠き部9の絶縁層で覆われているため、研削によっても高さは変化せず一定となる。磁極部5の高さは、ステップS4のめっき処理とステップS5のミリング処理によって定めることができ、この平坦化の処理では変化しない。切り欠き部9の部分は、磁気ヘッドを磁気記録面側から見たとき、磁極部5上に形成された絶縁材によって確認することができる(ステップS7)。

【0088】次に、図5(h)において、平坦化した埋設部8の上面にコイル用レジストを形成し(ステップS8)、コイル層10を形成する(ステップS9)。このコイル層10を絶縁層11で覆って平面を形成した後、該平面上に再度コイル用レジストを形成し(ステップS10)、次のコイル層11を形成する(ステップS11)。これを繰り返すことによって、コイル層を積層することができる。

【0089】コイル層を形成した後、図7(f)に示すように、絶縁層11の上部にヨーク部12を形成する。ヨーク部12の両端は、磁極部5の露出面上及び磁極柱6の露出面上に形成し、磁極部5とヨーク部12と磁極柱6とを磁気的に接続し、これによって上部磁極を構成する。このとき、ヨーク部12を形成するパーマロイ等の磁性材の組成は、磁極部5や磁極柱6と同じとすることも、あるいは異なるものとすることもできる(ステップS12)。

【0090】ヨーク部12を形成した後、記録ヘッド部と外部とを接続する引き出し端子(図8中で113で示す)を形成した後(ステップS13)、図5(i)に示すように、上部を非磁性材で覆い、オーバーコート部13を形成する(ステップS14)。

【0091】オーバーコート部13の上面を機械加工により引き出し端子113の端面を露出させ(ステップS15)、該引き出し端子113の端面に端子114をめっきで形成する(ステップS16)。

【0092】機械加工によってスライダーに加工すると

共に、磁気記録面を深さ方向に研削して、ギャップ深さを設定する。ギャップ深さの間では磁極部5上に切り欠き部9があるため、磁気記録面を深さ方向に研削しても、磁極部5の厚さは変化しない。磁気ヘッドを磁気記録面側から見たとき、磁極部5、磁極部5上に形成された切り欠き部9の絶縁材、及びオーバーコート部13の絶縁材は確認することができる。

【0093】なお、図5(i)中には、一点鎖線は磁極部を磁気記録面方向から見た断面(一点鎖線の位置)を示している。この位置では、切り欠き部9は存在しないため、ヨーク部12は絶縁材を介すことなく層磁極部5上に直接接触している(ステップS17)。

【0094】本発明の磁気ヘッドの実施形態によれば、以下の(a)～(j)の各効果を奏すことができる。

【0095】(a) 磁極部上に切り欠き部を備えることによって、磁極部の高さ(厚さ)はギャップ深さによる影響を受けず、高さ制御が容易となる。ギャップ深さのばらつきは、従来の0.5μmからほぼ0とすることができます。

【0096】(b) 磁極部と磁極柱の形成において、磁極部の高さを磁極柱より低く形成することによって、CMPによる平坦化の精度を高めることができる。磁極柱の高さのばらつきは、従来の0.4μmから0.2μmとすることができます。

【0097】(c) ギャップ深さを磁極部の作成時に定めることができるために、磁極部の高さとギャップ深さの差のばらつきを減少させることができ、磁気特性のばらつきを減少させることができる。磁極部の高さとギャップ深さの差のばらつきは、従来の0.3μmから0.1μmとすることができます。

【0098】(d) 磁極部とヨーク部とを個別に形成することによって、磁極部のトラック幅を狭くすることができる。アスペクト比10で、0.5μmのトラック幅を得ることができる。

【0099】(e) 磁極部とヨーク部とを個別に形成することによって、めっきによる形成においても組成変動を減少させることができる。磁極部とヨーク部との組成変動のばらつきは、3wt%から0.5wt%に改善することができる。

【0100】(f) 磁極部とヨーク部とを個別に形成により磁極部の飽和磁束密度Bsを高めることによって、記録磁界を高め、O/Wを改善することができる。

【0101】(g) 磁極部とヨーク部とを個別に形成によりヨーク部の厚さを磁極部より薄くすることによって、ヨーク部のインダクタンスを低減して、NLTS(線形性)を改善することができる。

【0102】(h) 磁極部とヨーク部とを個別に形成によりヨーク部を磁極部より高抵抗とすることによって、渦電流損を低減し、高周波特性を高めることができます。

(i) 磁極部、磁極柱及び埋設部を平坦化することによ

って、埋設部上にコイルを直接に配置することができ、コイルの配置ピッチを狭めることができる。また、埋設部をアルミナ等の熱伝導性の高い絶縁材とすることによって、コイルによる発熱の放熱性を高めることができます。

【0103】コイルピッチは、1.5μmとすることができます。また、温度上昇を抑えることが出るため、温度上昇によるコイル抵抗の上昇を抑制することができる。

【0104】(j) 磁極部、磁極柱及び埋設部を平坦化において、CMPによって磁極部及び埋設部を切削することによって、良好な平坦性と寸法精度を得ることができます。

【0105】本発明の磁気ヘッドにおいて、磁気記録面を浮上面とするスライダーとすることによって、磁気記録装置をることができます。

【0106】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、狭いトラック幅を備えることができ、ギャップ深さの容易な制御が容易とすることができます。また、上部磁極の組成変動や膜厚の不均一を抑制し、磁気特性の制御を容易とすることができます。

【0107】これによって、磁気記録分離型磁気ヘッドを小型化し、高容量化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の磁気記録分離型磁気ヘッドを説明するための概略図である。

【図2】本発明の磁気記録分離型磁気ヘッドの概略図である。

【図3】本発明の磁気記録分離型磁気ヘッドを形成する手順を説明するためのフローチャートである。

【図4】本発明の磁気記録分離型磁気ヘッドを形成する手順を説明するための断面図である。

【図5】本発明の磁気記録分離型磁気ヘッドを形成する手順を説明するための断面図である。

【図6】本発明の磁気記録分離型磁気ヘッドを形成する手順を説明するための斜視図である。

【図7】本発明の磁気記録分離型磁気ヘッドを形成する手順を説明するための斜視図である。

【図8】記録再生分離型磁気ヘッドの一構成例の概略図である。

【図9】記録再生分離型磁気ヘッドの一構成例の断面図である。

【図10】従来の磁気ヘッドの一形成工程例を示す図である。

【図11】従来の磁気ヘッドの問題点を説明するための図である。

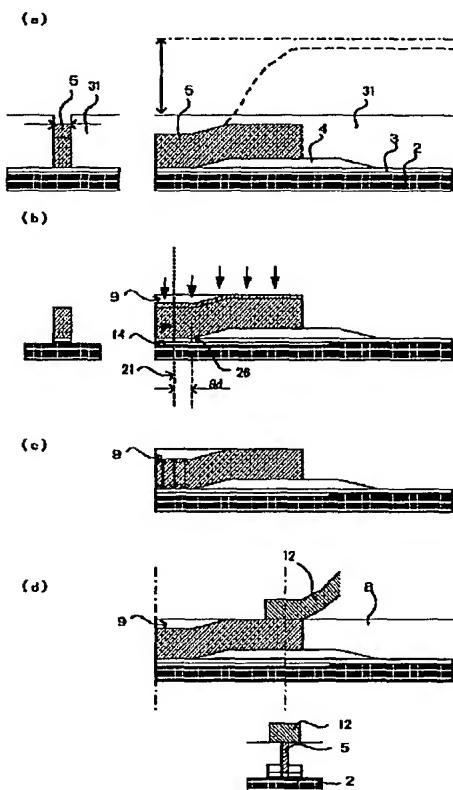
【図12】従来の上部磁極を形成するためのレジストを説明するための概略斜視図である。

【符号の説明】

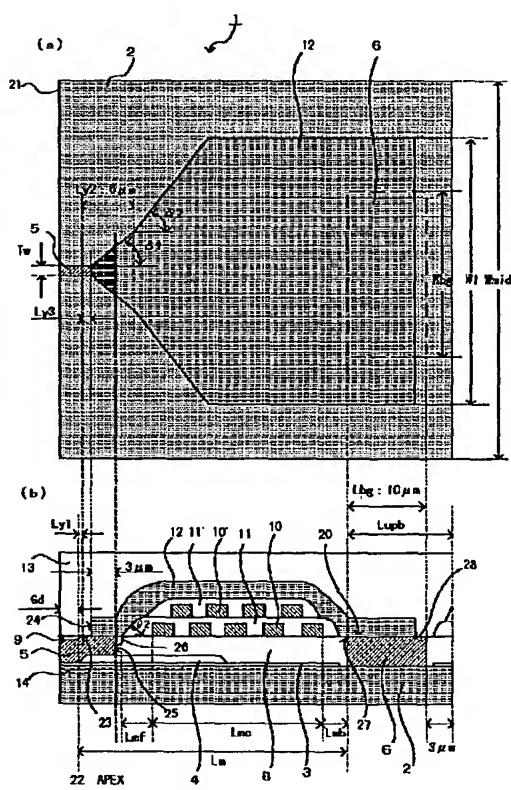
- 1 磁気ヘッド
- 2, 101 下部磁極
- 3, 103 ギャップ層
- 4, 104 ギャップ深さ規定用絶縁層
- 5, 105 磁極部
- 6 磁柱
- 7 非磁性層
- 8 埋設部
- 9 切り欠き部
- 10, 10', 110, 110' コイル層
- 11, 11', 111 絶縁層
- 12, 112 ヨーク部

- 13 オーバーコート部
- 14 ミリング部
- 15, 115 バックスルーホール
- 20 平面
- 21 磁気記録面
- 22 先端位置 (APEX)
- 23, 24, 27, 28 端部
- 25, 26 後端
- 31, 32, 131 レジスト
- 33, 133 溝
- Tw トラック幅
- Gd ギャップ深さ

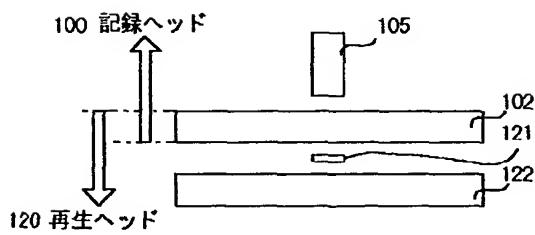
【図1】



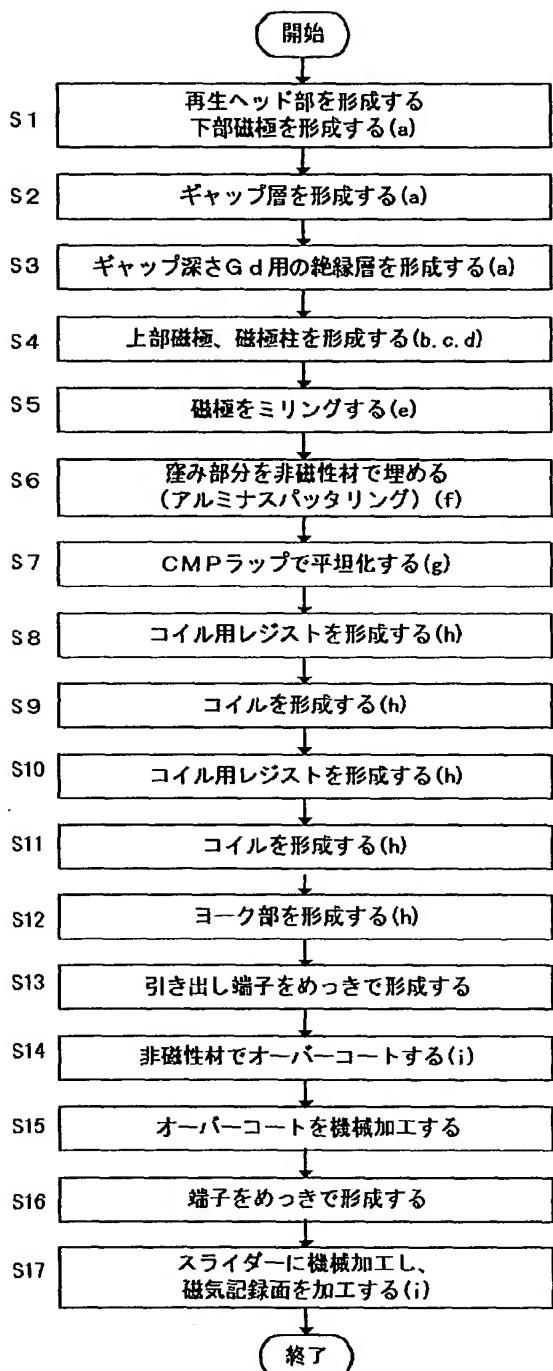
【図2】



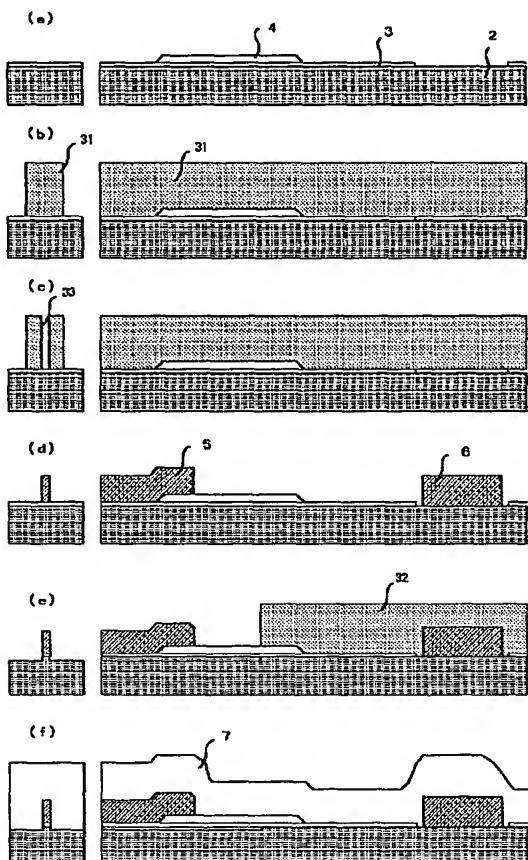
【図9】



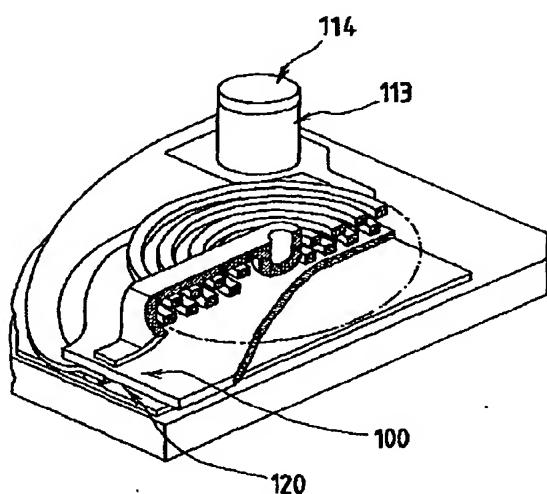
【図3】



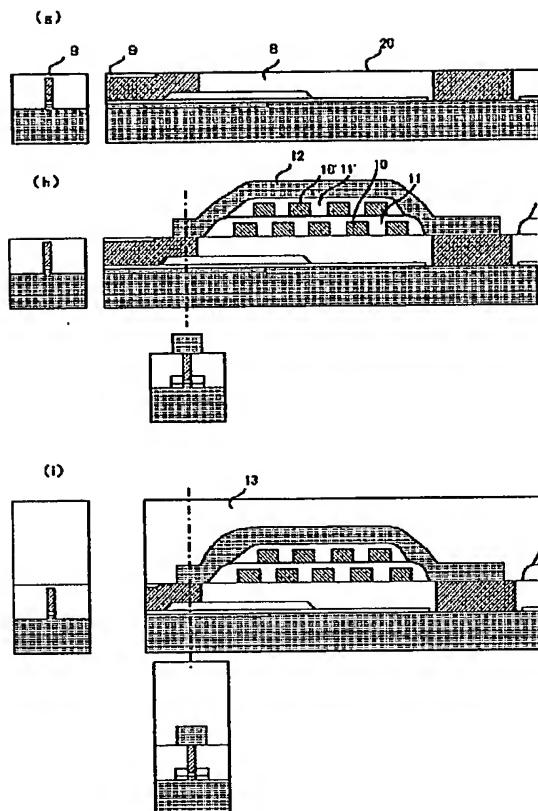
【図4】



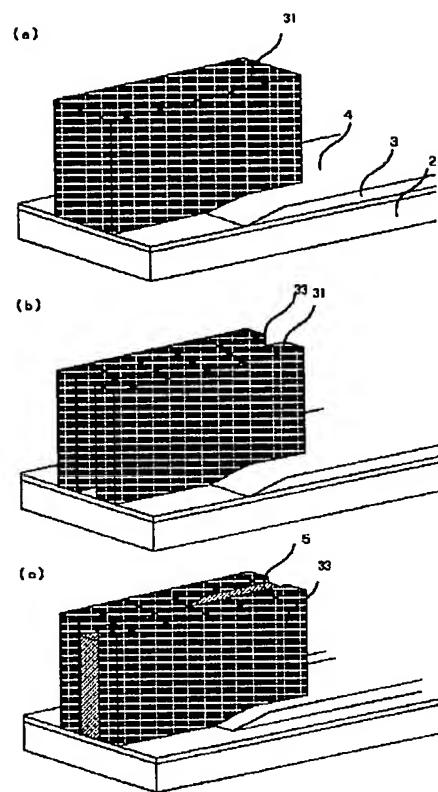
【図8】



【図5】

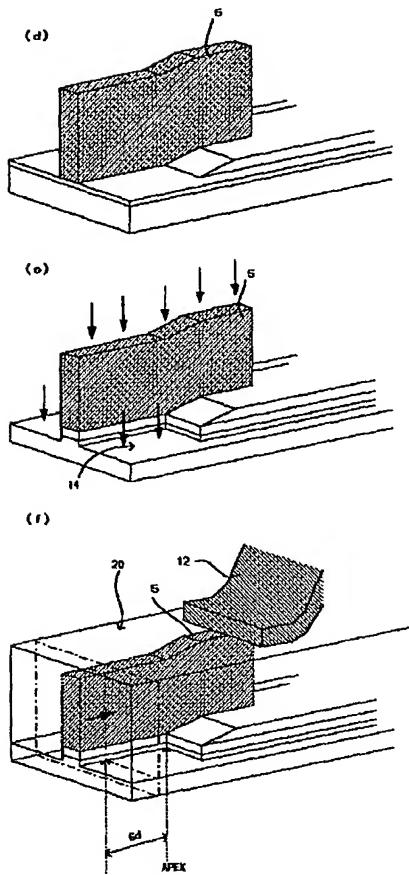


【図6】

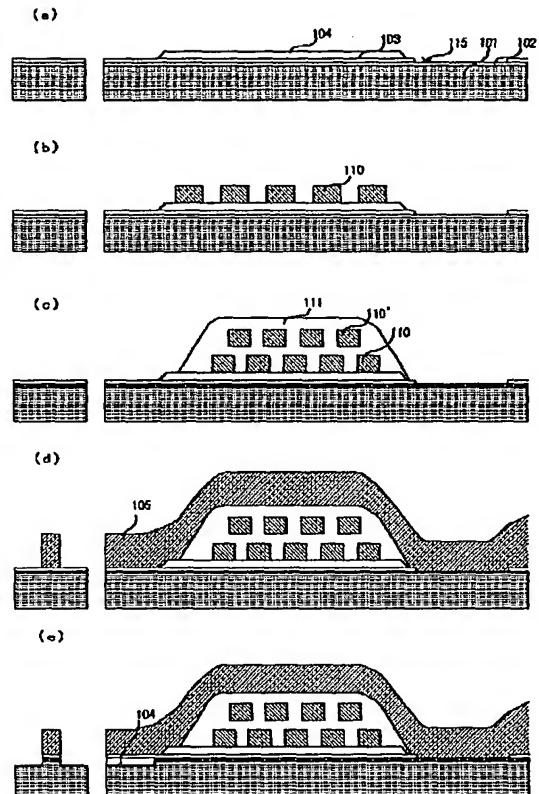


(14) 00-276707 (P2000-27JL8

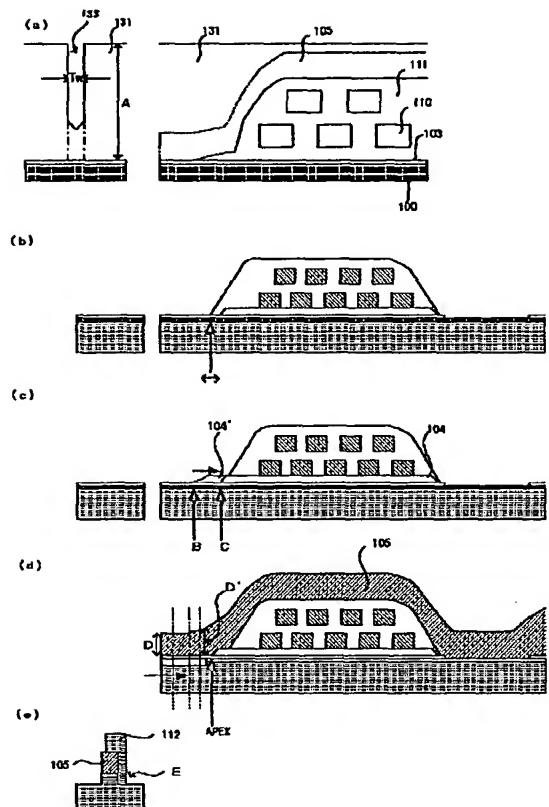
【図7】



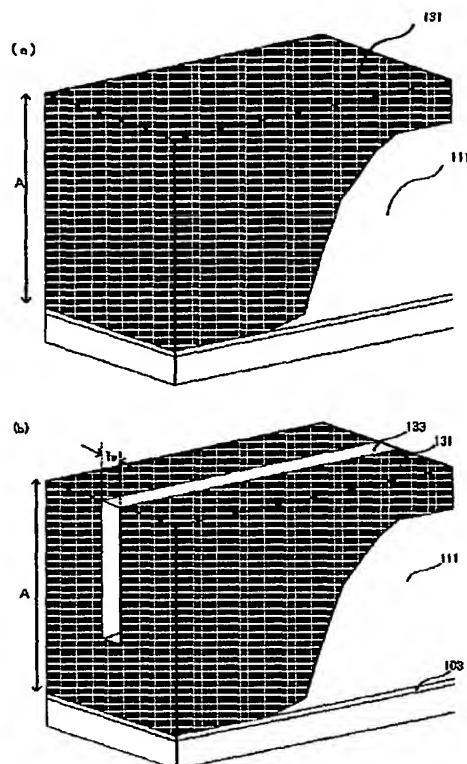
【図10】



【図11】



【図12】



フロントページの続き

(72)発明者 目黒 怜
栃木県真岡市松山町18番地 日立金属株式
会社電子部品事業部内

(72)発明者 福井 宏
埼玉県熊谷市三ヶ尻5200番地 日立金属株
式会社磁性材料研究所内

(72)発明者 鳥居 善三
栃木県真岡市松山町18番地 日立金属株式
会社電子部品事業部内

(72)発明者 池内 執一
栃木県真岡市鬼怒ヶ丘13番地 日立金属株
式会社真岡工場内

F ターム(参考) 5D033 BA07 BB43 DA02